



主要特点

反射式设计

内部集成TTL驱动

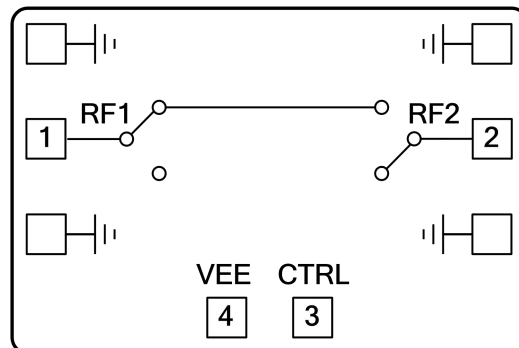
插入损耗: 1.0 dB

隔离度: 45 dB

输入/输出: 50 Ohm 匹配

芯片尺寸: 1.2×0.8×0.1 mm³

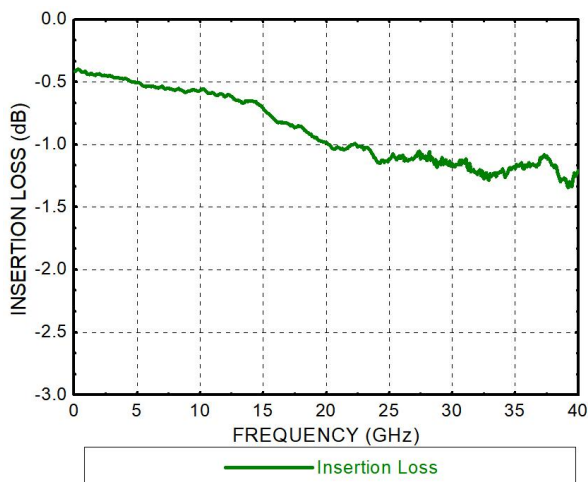
功能框图



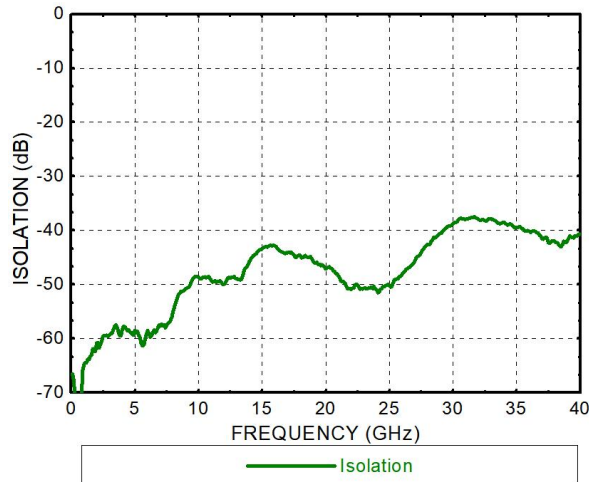
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 40			GHz
插入损耗		1.0		dB
隔离度		45		dB
回波损耗“打开状态”		18		dB
输入功率 1dB 压缩点@1-40GHz		26		dBm
开关切换时间		15		ns

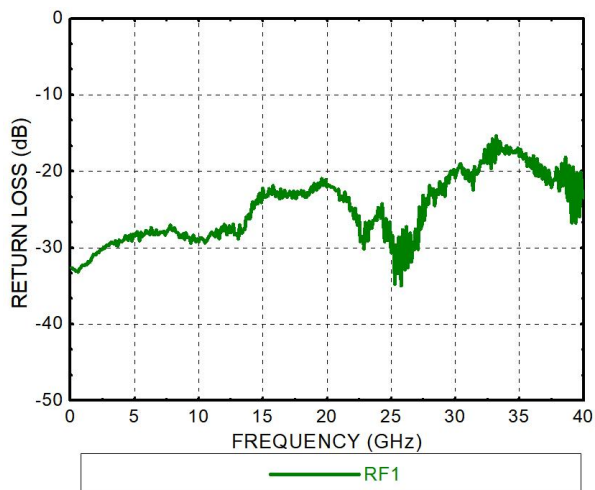
插入损耗



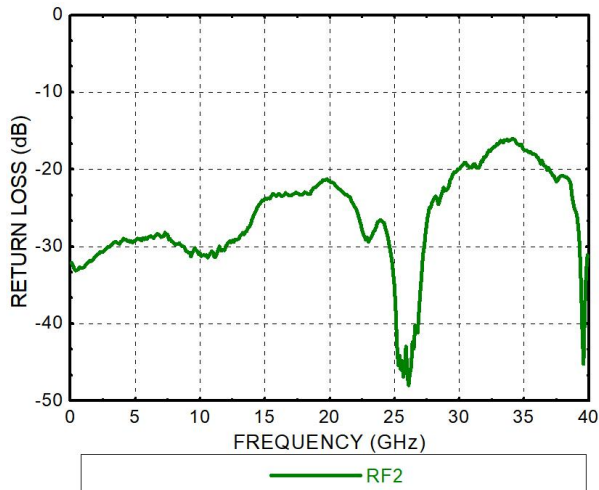
隔离度



RF1回波损耗“ON”状态

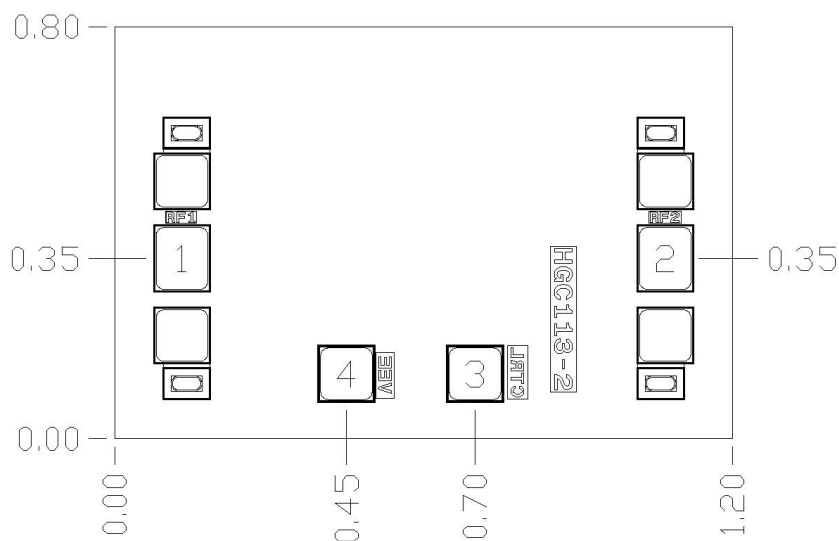


RF2回波损耗“ON”状态



物理参数

单位: mm



焊盘描述

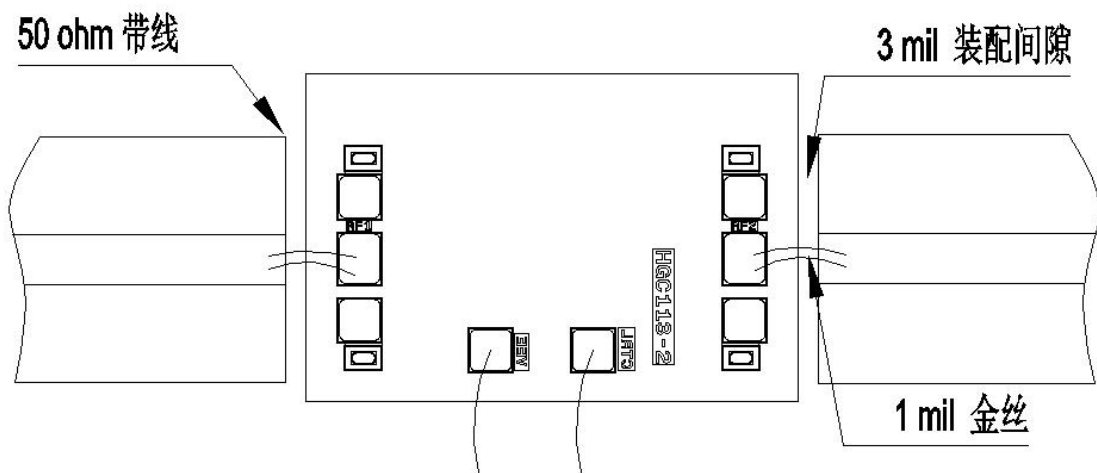
焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是输入输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm。如果 RF 电位不是 0V, 需要外接隔直电容
3	CTRL	该焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
4	VEE	该焊盘是数字电路电源端口, 接-5V 电源电压
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

功能	CTRL
ON	1
OFF	0
“0” 电平范围：0~0.8V，“1” 电平范围：2.3~5V。	

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100um
3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100um²
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6um

极限参数

1. 射频输入功率：+27 dBm
2. 储存温度：-65~+150℃
3. 工作温度：-55~+85℃